平成 28 年度 若狭研究室 夏の研究会 [第 27 回]

2016年 9月3日·4日

群馬県 水上温泉 松乃井

若狭研究室 OB

- 石井 伸治
- 前山 智明
- 高篠 鮎人
- 武田 知也

若狭研究室

- 若狭 雅信(教授)
- 矢後 友暁(助教)
- 江頭 友衣 (M2)
- 熊谷 零 (M2)
- 高橋 伶奈 (M2)
- 前田 隆宏 (M1)
- 水野 智久 (M1)
- 吉田 朋美 (M1)
- 石川 慶 (B4)
- 土田 暉 (B4)
- 長谷川 貴一 (B4)

発表プログラム

1. シングレットフィッションのレベルクロス機構による磁場効果

石川 慶

2.イオン液体中でのケチルラジカル生成

土田 暉

3.ゲルミレンの発生を目指したオクタイソプロピルシクロテトラゲルマンの光 化学

長谷川 貴一

4.光学的手法を用いたゲルマノンの新規発生法の開発

前田 隆宏

5. ベンゾフェノン水素引抜反応におけるパルスマイクロ波を用いた炭素磁気同 位体濃縮法の開発

水野 智久

6. ルブレンのシングレットフィッションに対する高磁場効果

吉田 朋美

7. イオン液体中におけるベンゾフェノンの二段階励起光化学

江頭 友衣

8. 芳香族チオケトン結晶の光化学

熊谷 零

9. 三重項増感反応によるゲルミレンの発生とその反応性の検討 高橋 伶奈

10.シングレットフィッションに対する磁場効果の理論的解析

矢後 友暁

シングレットフィッションのレベルクロス機構による磁場効果

B4 石川 慶

【序】 シングレットフィッションは励起一重項状態の分子と基底一重項状態の分子が2つ の励起三重項状態の分子になる光化学反応のことである。この反応は一つの光子から二つの 励起子を生み出すという特殊な反応であるため太陽電池の変換効率を高めることができると 考えられており、近年研究が盛んにおこなわれている。しかし、シングレットフィッション の反応機構はまだ明らかにされていないため太陽電池の応用にも至っていない。私はシング レットフィッションの機構を研究するためシングレットフィッション材料として知られてい るジフェニルへキサトリエン(DPH)に磁場を印加し、蛍光強度の磁場効果を観測した。DPH は高磁場領域でレベルクロス機構による蛍光強度の減少(dip)がすでに観測されている^[1]。 私はこの dip の位置が分子の配向によって変化するのではないかと考え、この磁場効果の観 測を行った。

【実験】 測定にはジフェニルへキサトリエン(DPH, Figure1) の薄層結晶、結晶を粉末化したものを用いた。LED による励 起光を 365 nm、蛍光の観測波長を 460 nm に設定し 0~5 T の磁 場効果を観測した。この際分光器の前には 460 nm のバンドパ スフィルターを装着した。測定の際、試料は Ar 雰囲気下に置 き、チラーを用いて保温ジャケットの温度を 20 ℃に設定し測 定を行った。





【結果と考察】 今回の実験では Figure2 のようなグラフが得られた。R(B)は相対蛍光強度 を表しており、ある磁束密度 B (T)のときの蛍光強度を 0 (T)での蛍光強度で割ったものであ る。このグラフを見ると粉末、結晶の場合それぞれ 0.08 T 付近に蛍光強度の減少、0.08 T 以 降に蛍光強度の上昇がみられている。この原因は Merrifield らによって説明されている^[2]。 また、高磁場領域で dip が観測されている。この原因はレベルクロス機構によって説明でき る(Figure3)。分子の交換相互作用 J を考慮すると一重項(S)、三重項(T)、五重項(Q)は Figure3 のようなエネルギー差を生む。ここに磁場を印加していくとゼーマン分裂によるエネルギー 変化が起こる。そして、ある磁場で一重項と三重項、一重項と五重項あるいは三重項と五重 項のエネルギー準位が縮退する。これにより異なるスピンの混合が生じ、一重項の割合が一 時的に小さくなり蛍光強度の減少が起きる。今回の実験では粉末の場合 4.5 T に大きな dip、 2.2 T、3 T に小さな dip が見られた。また、結晶の場合 3 T に大きな dip、 2.2 T、4.5 T に小 さな dip が見られた。この dip の位置は Figure 3 の 3J、4J、6J がそれぞれ 2.2 T、3 T、4.5 T と一致していると考えている。粉末の場合と結晶の場合で dip の強さに変化が見られたため 分子の配向によってレベルクロス機構に変化が見られると予想した。



Figure 2(a). Magnetic field effects on fluorescence of

DPH.

(b). Enlarged view of Fig. 2(a)



Figure 3. Level cross mechanism on Zeeman splitting

[1] M. Wakasa, M. Kaise, T. Yago, R. Kato, Y. Wakikawa, T. Ikoma, J. Phys. Chem. C. 2015, 119,

[2] R. E. Merrifield, Pure Appl. Chem. 1971, 27, 4810498.

2016.9.3 夏の研究会

イオン液体中でのケチルラジカル生成

B4 土田暉

【序論】

イオン液体とは常温で液体の塩である.低融点の塩として 19 世紀後半より関 心がもたれ始め, 1990 年代初頭に空気や水に安定な常温溶融塩が報告された¹⁾. 近年,その特異な性質より様々な分野で研究がおこなわれている.イオン液体に は不揮発性,熱安定性,高デザイン性,ナノスケール構造を作りやすいなど特異 な性質がある²⁾.

先行実験ではラジカル対に磁場をかけることでスピン変換の速度が変化し、 ラジカルの収量を変化することからイオン液体のナノスケール局所構造を見積 もる実験を行ってきた.イオン液体N,N,N・トリメチル・N・オクチルアンモニウムビス (トリフルオロメタンスルホニル)イミド(TMOA TFSI), N,N,N・トリブチル・N・ヘキシルア ンモニウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド(TBHA TFSI)中でのベンゾフェノ ン(BP),ジアザビシクロオクタン(DABCO)系の磁場効果を観測している.

本実験ではTBHA TFSI中でのみ生成するケチルラジカルの生成についての磁場効果の 観測を試み,局所構造について考察する.

【実験】

イオン液体 N,N,N・トリブチル・N・ヘキシルアンモニウムビス(トリフルオロメ タンスルホニル)イミド(TBHA TFSI)を合成し、ヘキサンと水で洗浄し、真空乾 燥を行った. BP 10 mM, DABCO 20 mM の TBHA TFSI 溶液を調整し、50℃ における過渡吸収測定を行った.励起光には Ne:YAG レーザーの第三高調波 (355 nm)を使用し、検出光源には Xe フラッシュランプを使用した.温度調整 には IWAKI CONSTANT TEMPERATURE SYSTEM(CTS-134A)を使用した.

【結果と考察】

Figre1 に 50 ℃の過渡吸収スペクトル(BP DABCO in TBHA TFSI),Figre2 に 常温の過渡吸収スペクトル(BP DABCO in TBHA TFSI)を示した. 530 nm のピ ークは BP の TT 吸収によるもので 400 ns ではっきりしてくる 550 nm のピ ークはベンゾフェノンケチルラジカルによる吸収である. 50 ℃のスペクトルと 25 ℃のスペクトルのケチルラジカルの吸収である 550 nm の吸収を比べると, 温度(粘度)によるケチルラジカル生成の有無に違いがないことが見て取れる. ま た, 550 nm の吸収が一定値に近づくまでの時間が異なることがわかる.



Figure1:50 ℃の過渡吸収スペクトル(BP [10 mM] DABCO [20 mM] in TBHA TFSI)



Figure2:25 ℃の過渡吸収スペクトル(BP [10 mM] DABCO [20 mM] in TBHA TFSI)

【参考文献】

 J.S.Wilkes, M.J.Zawarotko, J.chem.Soc., Chem.Commun., 1992, 965.
 イオン液体研究会監修(西川恵子,大内幸雄,伊藤敏幸,大野弘幸,渡邉正義 著), "イオン液体の科学 -新世代液体への挑戦-", p1-10, 丸善出版(2012) ゲルミレンの発生を目指したオクタイソプロピルシクロテトラゲルマンの光化学

序論

14族元素間のσ結合をもつオリゴマーおよびポリマーは光化学的、電気化学 的に興味深く、中でも環状ケイ素化合物の光化学特性、反応性は盛んに研究が行 われている。対して環状ゲルマニウム化合物の光反応の反応性や反応機構は解 明されていない部分が多い。4員環ゲルマニウム化合物のオクタイソプロピルシ クロテトラゲルマン(1a)は光照射により 2 価化学種ジイソプロピルゲルミレン を放出するとされていたが、近年の報告によりテトラゲルマン・1,4・ジイルビラ ジカル(1a')が発生することが分かった。

そこで本研究では、オクタイソプロピルシクロテトラゲルマン(1a)に2段階励起 法を用いてゲルミレンの発生を試みる。



実験

・オクタイソプロピルシクロテトラゲルマン(1a)の合成 下記の手順に従って 1a を合成する。

$\operatorname{GeCl}_{4} \xrightarrow{{}^{i}\operatorname{PrMgCl}} {}^{i}\operatorname{PrGeCl}_{3} \xrightarrow{\operatorname{CH}_{3}\operatorname{COCl},\operatorname{AlCl}_{3}} {}^{i}\operatorname{Pr}_{2}\operatorname{GeCl}_{2} \xrightarrow{\operatorname{BeMgCH}_{2}\operatorname{CH}_{2}\operatorname{MgBr}} {}^{i}\operatorname{Pr}_{2}\operatorname{GeCl}_{4}$

 ・オクタイソプロピルシクロテトラゲルマン(1a)の過渡吸収測定
 濃度1.7×10⁻³ mol dm⁻³ の 1a のシクロヘキサン溶液の過渡吸収測定を行った。Nd:YAG レーザーの 266nm を励起光、キセノンフラッシュランプを検出 光とした。

結果・考察





過渡吸収スペクトルの 550 nm 付近に吸収が見られることから、これが光照射 により発生するビラジカル 1a'の吸収であり、2 段階目の励起光の波長として第 2 高調波(532 nm)を用いれば、ゲルミレンが発生すると予想される。

参考文**献**

[1]M.Wakasa,Y.Takamori et al.Organometallics,2007,692,2855-2860.[2]高森裕也、修士論文(2005)

光学的手法を用いたゲルマノンの新規発生法の開発

M1 前田隆宏

【序 14 族元素である炭素,ケイ素,ゲルマニウム,スズ,鉛は高いデザイン性や反応性 を持つことが知られている.特に高周期14 族元素であるケイ素,ゲルマニウムは炭素とは 異なる性質や反応性を示し,その特異な性質から,化学結合や化学反応のメカニズムを解明 する上で重要であると注目されている¹⁾²⁾.

近年松尾らによって非常に嵩高い置換基である Eind 基を用いたヘビー級ケトンである ゲルマノンの単離・精製が報告された³⁾. このゲルマノンは通常ケトンと反応しないアセト ンや二酸化炭素と反応することが報告されている.本研究ではより小さい置換基を用いた ゲルマノンを光学的手法を用いて発生させることを目的として,アリールジゲルマノキサ ンの光化学反応の検討を行った.

【実験 アリール基としてフェニル基を用いたヘキサフェニ ルジゲルマノキサンの合成を行った.ナノ秒過渡吸収法およ び捕捉剤を用いた定常光照射実験によりヘキサフェニルジゲ ルマノキサンの光化学反応性の検討を行った.ゲルマノンの 前駆体と考えられるトリフェニルゲルモキシラジカルが 360



nm 付近に吸収を持つことから二段階目の励起光として Nd-YAG レーザーの第 3 高調波 (355 nm パルス幅:5 ns)を励起光とした二段階励起実験を行った.

【結果と考察 ヘキサフェニルジゲルマノキサンのシクロヘキサン溶液に Nd-YAG レー ザー第4高調波を照射したところ,320 nm 付近及び 360 nm 付近に吸収のピークが見られ た(Fig 1). 捕捉剤として四塩化炭素を添加し,それぞれの波長において減衰の測定をしたと ころ,320 nm において減衰の変化が見られたが,360 nm においては変化がみられなかっ た(Fig2).また,捕捉剤としてイソプレンを添加すると,360 nm において減衰曲線の変化 が見られた(Fig 3). これらの結果から, 320 nm における吸収極大はゲミルラジカルによる

ものであり, 360 nm における吸 収極大はゲルモキシラジカルに よるものであると帰属した. 二段階目の励起光を 355 nm と し二段階励起実験を行ったとこ ろ, 400 nm において, 二段階目 のレーザーが照射した瞬間から 吸光度の上昇が観測された.



新しく観測された 400 nm における吸収を帰属するために四塩化炭素を添加して細く実験 を行った.この結果から、新しく現れた成分は四塩化炭素で補足できると言える.





Fig2. Changes in the decay curve of 320 nm

Fig1. Spectrum data and 360 nm



Fig3. Changes in the decay curve of 360 nm





Fig.5



Fig4. Decay curve of 400 nm(two laser

extitation)

2016.9.3 夏の研究会

ベンゾフェノン水素引抜反応における パルスマイクロ波を**用**いた炭素同位体濃縮法の開発

M1 水野 智久

【序論】一般的な同位体の濃縮は、質量差に基づく性質の差によって行われるため、重原 子ほど性質の差が小さくなり濃縮が困難である.そこで、新たな濃縮法として核スピンの 差(磁気同位体効果)を利用した濃縮法が研究されてきた.そのなかでも収量検出磁気共鳴 (RYDMR)の原理を応用し、光反応で生じる三重項ラジカル対にマイクロ波を作用させスピ ン変換を制御するという手法は、片方の同位体のみをラジカルの準位選択的に濃縮できる ことが報告⁽¹⁾されているが、生成物の単離はいまだ報告されていない.本研究室では、岩見 らによって磁気同位体濃縮に関して研究⁽²⁾が行われており、反応生成物の単離が報告されて いるが、濃縮効果は得られていない.

今回の報告では,Brij35 ミセル水溶液 中におけるベンゾフェノンの水素引き 抜き反応(Fig1)において,結合生成物収 量に対する磁場効果および,マイクロ波 の照射位置の確認のため,時間分解ESR を測定したので報告する.



Fig 1. 本研究で用いる反応系

【実験1】再結合生成物収量に対する磁場効果の測定

ベンゾフェノン1mM, Brij35 50 mMの水溶液をフローさせながら反応を進行させた.励 起光にはXe ランプの定常光を使用した.照射光を330 nm以下の波長を遮断するフィルタ ーに透過させることで二次反応の可能性を排除した.再結合生成物の分離・定量には,GPC カラムを用い,観測された収量変化から再結合生成物収量に対する磁場依存性を求めた.



Fig 2 より、磁場の印加とともに 再結合生成物の収量が減少する 磁場効果が発現しており、同位 体濃縮を試みる磁場付近である 3500 G では 18.4 %程度の磁場効 果が生じることが明らかとなっ た.

Fig 2. 再結合生成物収量に対する磁場効果

【実験 2】時間分解 ESR 測定

ベンゾフェノン 1 mM, Brij35 50 mM の水溶液を φ0.75 の ESR 管にフローしながら反応を 進行させた.励起光には Nd:YAG LASER の第 4 高調波(266 nm)を使用した.マイクロ波に は、9.539241 GHz, 1.006 mW の連続波を用いた.





Fig 3. 励起後 1.2 µs 後の時間分解 ESR スペクトル

Fig 3 には励起後 1.2 µs 後の時間分解 ESR スペクトルのほかに, PEG radical(Brij35 radical) のスペクトルシミュレーションと反応途中で生成する PEG radical, ベンゾフェノンケチル ラジカル BPH(¹²C, ¹³C はカルボニル炭素の質量数)の存在比を示した.シミュレーションと の比較により,信号の位置はよく再現されていることが分かった. ラジカルの存在比とス ペクトルの比較により ↓ 赤矢印の周波数が BPH(¹²C)由来の信号の中央であり,この位置に パルスマイクロ波を打ち込むことで同位体濃縮を試みることが可能であることが分かった.

今後の予定

- ・パルスマイクロ波効果の検討
- ・ベンゾピナコールの単離・収集
- ・GC-MS 装置を用いた同位体比測定の検討

参考文献

(1)Okazaki, M; Toriyama, K, *J.Phys.Chem.*, 99, 489(1995).(2)岩見法之,修士論文(2011)

平成28年度夏の研究会

ルブレンのシングレットフィッションに対する高磁場効果

M1 吉田 朋美

【序】シングレットフィッション (SF) とは、有機分子において、光励起によって生じ た一重項励起子が、隣接する基底状態の分子に励起エネルギーを分け与えて、2つの三 重項励起子になる現象である.この現象によって1つの光子から2つの励起子を得るこ とができるという点で、太陽電池の高効率化が期待されており、光化学および光物理学 分野で現在盛んに研究が行われている[1].SF 過程は磁場効果を示すことが知られてい る.SFのメカニズムについて、磁場効果から解明の試みがなされてきた[2].SF に対す る磁場効果のメカニズムの基礎は Merrifield らによって 1970 年代に確立された[3].こ れまでの磁場効果の研究では電磁石が用いられ、磁場の範囲は2T以下に限定されてい た.そこで詳細な SF のメカニズムの解明を目指して、蛍光に対する5Tまでの高磁場 効果を観測しておりこれまで、DPHの高磁場効果からSFのメカニズムに関する新たな 知見を得ることができた[4].





SF 過程 (Figure 1) では、スピン禁則制に従って一重項励起子から一重項性の三重項 対が形成されることが知られている. 逆過程もこの規則に従い一重項性の三重項対から 一重項励起子へ遷移 (再結合) すると蛍光を発する. 三重項対は9つのスピン状態を有 しており、磁場によってこれらの固有状態が変化することで、一重項性から他の多重度 への変換確率も変化する. 上記の通り、SF および再結合過程はスピン禁則制に従うの

で、三重項対が一重項性以外の多重度を持つと再結合をすることがで きない.つまり、磁場効果を受けるのは三重項対のスピン状態である が、スピン禁則制によって再結合過程にこの効果が反映されるため、 蛍光に磁場効果が発現する.従って、磁場印加に対する蛍光強度を測 定することで、SF に対する磁場効果の観測を行うことができる.



本報告では, SF 材料として知られているルブレン (Figure 2) の蛍光 に対する高磁場効果から SF のメカニズム解明を目指した.

Figure 2. Rubrene

【実験】0~5 T の磁場印加を行うことのできる超電導マグネット (SCM) を用いて,ル ブレン粉末 (Aldrich,昇華精製グレード)の磁場印加に対する蛍光強度の測定を行った. 粉末の励起および蛍光スペクトルから,励起波長を 530 nm,観測波長を 640 nm に設定 した (検出側にバンドパスフィルターを使用).また,試料の励起は LED ランプを使用 した.試料は,試料を乗せた台座を先端に挟みこんだ励起・検出用のファイバーの束を, SCM 内に挿入された保温ジャケット (20 ℃) に入れて設置した.また,試料の劣化を 防ぐため測定はアルゴン雰囲気下で行った.

【結果と考察】

ルブレンと DPH[4]の蛍光に対する磁場 効果を Figure 3 に示す. DPH との比較か ら,ルブレンの磁場効果が5Tまでで飽和 していないことがわかった.5Tまで飽和 していないということは,この磁場までは ゼーマン分裂によるスピン状態の解離が 十分でなく,スピン変換が起こるというこ とであるため,ルブレンにおいては三重項 対の寿命が長いことが考えられる.三重項 対の寿命が長いことからスピン緩和の効果の 寄与[5]が考えられた.スピン緩和を考慮したも



Figure 3. Magnetic field effects on the yield of the excited singlet state in rubrene and DPH.

のとしていないものの the stochastic Liouville equation (SLE) 計算から,ルブレンではスピン緩和の寄与が DPH よりも大きいことが分かった(Figure 4).



Figure 4. MFEs on the yield of the excited singlet state calculated by using the stochastic Liouville equation (black line) together with the experimentally observed MFE (red line). For left black line spin relaxation is took into acount, whereas for right one isn't.

- [1] M. Smith, J. Michl, Chem. Rev. 2010, 110, 6891-6936.
- [2] G. B. Piland, J. J. Burdett, R. J. Dillon, C. J. Bardeen, J. Phys. Chem. Lett. 2014, 5, 2312-2319
- [3] R. E. Merrifield, Pure Appl. Chem. 1971, 27, 481-498.
- [4] M. Wakasa, M. Kaise, T. Yago, R. Kato, Y. Wakikawa, T. Ikoma, J. Phys. Chem. C 2015, 119, 25840-25844
- [5] V. V. Tarasov, G. E. Zoriniants, A. I. Shushin, M. M. Triebel, Chem. Phys. Lett. 1997, 267, 58-64

2016年夏の研究会

イオン液体中におけるベンゾフェノンの二段階励起光化学

M2 江頭友衣

【序論】

励起状態にある分子や不対電子をもつラジカルは非常に反応性に富む反応中間体である ととらえることが出来る。これらを光励起させると励起状態は高励起状態に、ラジカルは 励起ラジカルになる。項励起状態は直ちに内部変換してしまう為その性質を測定する事は 困難である。しかし励起ラジカルは種類によっては過渡吸収測定で反応性を測定する事が 可能背ある。実際にベンゾフェノンやキサントンで二段階過渡吸収測定を行った報告があ る。その論文では水素引き抜き能力やハロゲン引き抜き能力の著しい上昇が報告された。

ー方イオン液体とは有機的なカチオン・アニオン分子からなる常温で液体の塩である。 不揮発性,電気伝導性,高い熱安定性などのいくつかの特異な特性を持っており,多くの 分野で注目されている。当研究室でも様々なイオン液体の研究が行われてきたが,N,N,N-トリブチル-N-ヘキシルアンモニウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド(TBHA TFSI)中において光励起によってベンゾフェノン(BP)の水素引き抜き反応が起こることが確 認された。

この先行研究から本研究ではイオン液体中においてベンゾフェノンの二段階励起を行い イオン液体中での励起**状態**ベンゾフェノンケチルの挙動について観測を行う



【実験】





脱水アセトニトリル中でトリブチルアミン(0.126 mol)に対して1-ブロモヘキサンを1当量作 用させ,加熱還流を行うことで N,N,N-トリブチル-N-ヘキシルアンモニウムヒドロキシド (TBHA OH)(1)を得た(0.116 mol,収率 92%)



得られた TBHA OH をイオン交換水 100 mL に溶かし, リチウムビス(トリフルオロメタンス ルホニル)イミド(Li TFSI)を1当量イオン交換水 100 mL に溶かした溶液と混ぜ合わせて室温 で攪拌し N,N,N-トリブチル-N-ヘキシルアンモニウムビス(トリフルオロメタンスルホニル) イミド(TBHA TFSI)(2)を合成した。

Fig.1 に合成したイオン液体の UV-vis スペクトルを示す。イオン交換水, ヘキサン, 活性炭 で洗浄を行うことで 250-350 nm における吸収帯が減少し不純物が取り除けたことが確認で きた。また 355 nm 付近に吸収帯をもっていないことから BP の過渡吸収測定に問題なく使 用出来ると考えられる。



Fig.1 TBHA TFSI の UV-vis スペクトル

【今後の予定】

合成によって得られたイオン液体を用いて BP の二段階励起測定を行う。また BP のアル コール中,ミセル中での二段階励起測定の結果と比較する。イオン液体中のみでの特異な 反応が得られた場合それについての考察を行う。

【参考文献】

[1] M. Sakamoto et al. J. Phys. Chem. A 2004, 108. 8147-8150
[2] M. Sakamoto st al. J. Phys. Chem. A 2005, 109. 2452-2458
[3] 武田知也,高粘度イオン液体中での電子移動反応と水素引き抜き反応に対する磁場効果の比較、学士論文, 2016

2016.09.03 夏の研究会

芳香族チオケトン結晶の光化学

M2 熊谷 澪

序論

芳香族チオケトンは、硫黄原子の重原子効果により励起三重項状態を精製しやすく、溶液中において、室温で燐光を発する、第二励起一重項状態 (S₂)から蛍光を発するなどの特異な性質が知られている¹⁾.しかし、芳香 族チオケトンの結晶における発光特性は未だに報告されていない.そこで

本研究では、結晶状態での芳香族チオケトンの発 光特性について明らかにすることを目的とする.

芳香族チオケトンであるキサンチオン (XT) 1 の 発光スペクトル (25 ℃, エタノール中)を Fig. 1 に 示す. 470 nm 付近に S₂からの発光, 690 nm 付近に T₁ または S₁ からの発光が見られる. これに対して, 結晶状態の XT は,発光を観測することができなか った. そこで, XT 分子内に蛍光分子を導入するこ とで、芳香族チオケトン結晶の発光特性を調査することとした.





4- ブロモキサントン6とボロン酸8をカップリングさせ、2を得る.

結果と考察

4-ブロモキサントン6の合成2)

フェノールに NaH を作用させてフェノキシドとした後,4-ブロモ -2-フルオロベンゾニトリル3 と反応させ、ジフェニルエーテル4を得た.これを NaOH 存在下で加熱し、カルボン酸5 とした.こ

れに対してトリフルオロ酢酸と三フッ化ホウ素を作用させ、4-ブロモキサントン6を得た.

ボロン酸8の合成



求核性を弱めるため, n – ブチルリチウムの代わりにマグネシウムを用いて反応を行ったが, 同様に 9 が生成してしまった. この原因はベンジル位の反応性の高さによるものと考えられる. 今後, マグネシウムへの 7 の滴下速度と反応温度を考慮して 8 の合成を試みる.

参考文献

1) Kumar, CV.; Qin, L.; Tang, Das, PK. J. Chem. Soc. 1984, 80, 783-793.

2) Tricyclic delta - opioid modulators. US 20110245291 A1

平成 28 年度 若狭研究室 夏の研究会 (2016/09/03)

三重項増感反応によるゲルミレンの発生とその反応性の検討

M2 高橋伶奈

【序論】

炭素(C)よりも下のケイ素(Si)、ゲルマニウム(Ge)、スズ(Sn)、鉛(Pb)は高周期 14 族元素と呼ばれ、炭素 の同族元素であるため化学的性質が似ていると予想されるが、それぞれ異なった性質をもち、現在も盛 んに研究が行われている ¹⁾. カルベンのゲルマニウム類縁体であるゲルミレンには. 一重項と三重項の 2 種類のスピン状態があるとされ、三重項状態の化合物はラジカル的な反応性をもつため、このような 14 族元素の triplet の単離は非常に意義のある課題とされている. また、安定な三重項感応性化学種の開発に より, 無輻射過程を抑制した強リン光性の発光材料などといった新物性を生かした機能性材料を創り出 すことが期待される.

そこで今回, 3,4-dimethyl-1,1-diphenylgermacyclopent-3ene(1)を出発物質とし、Xanthone を三重項増感剤として用 いることで,初めての三重項増感による三重項感応性化 学種ゲルミレン(Ph₂Ge)の発生と観測を行うことを目的と し、実験を行った.



Scheme.1 三重項増感反応によるゲルミレンの発生

【実験】

Nd:YAG レーザーを励起光、キセノンフラッシュランプを検出光としたナノ秒過渡吸収装置を用いて 増感剤の T-T 吸収波長における減衰を測定し、そしてその解析から 3Xn*から1へのエネルギー移動にお ける速度定数を算出した.

1. acetonitrile 溶液での速度定数

Xn 14 mM と濃度が 0, 1.16, 3.79, 6.16, 8.22 mM の 1 を溶質とする acetonitrile 溶液をそれぞれ調製し、 630 nm における減衰曲線を測定後, その変化を見た. そこから, [1] vs ktxnldecay のグラフを作成し, 速 度定数を決定した.

第三高調波(355 nm)を用い、積算 100、連続 20、インターバル 2 で測定を行った.

2. benzene 溶液での速度定数

Xn 8 mM と濃度が 0,1.50,3.08,5.33,7.19 mM の1を溶質とする benzene 溶液をそれぞれ調製し、 650 nm における減衰曲線を測定後, その変化を見た. そこから, [1] vs k_{[Xnldecav}のグラフを作成し, 速 度定数を決定した.

第三高調波(355 nm)を用い、積算 100、連続 20、インターバル 2 で測定を行った.

【結果と考察】 1. acetonitrile 溶液での速度定数 $k = 2.62 \times 10^9 \text{ M}^{-1} \text{s}^{-1}$



Figure.1 Xn(14 mM)と germacyclopentene(1) (0, 1.16, 3.79, 6.16, 8.22 mM)の 630 nm における減衰曲線(左)

Figure.2 [1] vs k_{[Xn]decay} (右)



2. benzene 溶液での速度定数 $k = 1.57 \times 10^9 \text{ M}^{-1} \text{s}^{-1}$

Figure.3 Xn(8 mM)と germacyclopentene(1) (0, 1.50, 3.08, 5.33, 7.19 mM)の 650 nm における減衰曲線 (左) Figure.4 [1] vs k_{[Xndecav}(右)

過去の過渡吸収スペクトル測定で 500 nm 付近に germylene と予想される吸収が観測された, acetonitrile 溶媒と benzene 溶媒において ³Xn*から1のエネルギー移動の速度定数を得た.しかし, ³Xn*と1が反応し ていることは明らかであるが, acetonitrile 溶媒中の反応は溶媒が極性溶媒であるため,電子移動反応であ る可能性も高く,一概にはエネルギー移動による速度定数とは言えない.このことから,2つの溶液にお いて,1の濃度変化による減衰曲線の移り変わりと速度定数の差は,それらが電子移動反応であるかエネ ルギー移動反応であるかにも関係していると予想する.

【今後の予定】

・捕捉剤添加によるゲルミレンの捕捉 (trans-3-hexene 等)

・捕捉後の化合物の同定

【参考文献】

1) William J. Leigh, Cameron R. Harrington and Ignacio Vargas-Baca, J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 16105-16116.

シングレットフィッションに対する磁場効果の**理**論的解析

(埼玉大院・理工) □矢後 友暁・若狭 雅信

Theoretical analysis on magnetic field effects on singlet fission (Saitama Univ.) <u>YAGO,Tomoaki</u>; WAKASA, Masanobu

Abstract: Singlet fission (SF) results in the formation of triplet pair (TP) in organic crystals. Although the SF processes have been known to shows the remarkable magnetic field effects (MFEs) on their efficiencies, the MFE study on SF has been entirely left behind by MFE study on radical pair (RP) due to the strict limitation of the materials which must be satisfied the energetic condition that the energy of the excited singlet state must be two times or more higher than the energy of the excited triple state. In this contribution, we apply a RP model to the analysis of MFE on TP generated by SF with a replacement of the spin Hamiltonian to describe the spin dynamics in TP. The experimentally observed MFE on SF can be well reproduced by our model, suggesting the RP model is available for the analysis of spin dynamics during the SF event.

【序】有機結晶中のシングレットフィッション(Singlet fission: SF)により、一つの励起一重 項から三重項対(Triplet pair: TP)が生成する。[1] 三重項の電子スピンが相互作用すること により、TP は一重項、三重項、五重項のスピン状態を持つ。励起一重項から一重項 TP への 遷移は、スピン状態が変化しないスピン許容遷移である。そのため、励起一重項のエネルギ ーが励起三重項のエネルギーの2倍以上というエネルギー条件を満たした場合、SF は速やか に進行する。SF が進行する有機結晶においては、蛍光強度が磁場の効果を受けることが知ら れている。[1] この蛍光に対する磁場効果(MFE)は、SF によって生じた TP のスピン状態 に対する MFE およびスピン選択的な三重項融合(Triplet fusion: TF or T-T annihilation)によっ て説明される。SF が効率よくおこる材料は非常に限られており、これまでの SF が関連する MFE は古典的な Merrifield のモデルにより解析されてきた。[2]

一方、ラジカル対(RP)が中間体として生成する光化学反応に MFE が表れることはよく 知られている。[3] RPは、光合成系、有機太陽電池、電子受容体一供与体連結系、ミセル中 の光化学反応など様々な反応系で観測することができる。そのため、MFE を含めた RP の研 究はこれまで盛んに行われてきており、実験方法や理論など蓄積された知識が豊富にある。 この RP での MFE モデルを SF に対する MFE の解析に応用できれば、これまで RP 研究で得 られた知見を SF 研究に活用することができる。そこで本研究では、RP モデルを用いて、SF で生じた TP のダイナミクスに対する MFE の解析を行った。

【モデル】Pederesen と Freed の RP モデル[4] に基づいた統計リュービル方程式を用いて解析 を行った。[5] (図1)はじめに SF によって近接した TP が生成する。RP と同様この SF 過 程は磁場の効果を受けない。生成した TP においては、交換相互作用(J) が働くため、スピ ン状態は磁場の効果を受けず、SF 直後の TP のスピン状態は常に一重項である。その後、三 重項の拡散により TP の距離が離れると、J が小さくなり一重項 TP の一部が三重項ま たは五重項 TP に変換される。このスピン 変換過程が磁場の影響を受ける。磁場がな い条件ではスピン変換が効率よく起こるた め、一重項 TP の占有数が減少する。一方、 大きな磁場が印加されている場合には、ス ピン準位のゼーマン分裂によりスピン変換 が抑制される。そのため、TP は一重項状態 に留まりやすくなる。拡散によって離れた TP は、さらなる拡散により孤立した三重項 になるか、または再び近づき近接した TP となる。 この TP のスピン状態が一重項であれば TF がス ピン許容となり効率よく進行する。このスピン

選択的なTFにより、離れたTPでのスピン変換 過程が励起一重項の占有数に反映され蛍光強度 に磁場効果が表れる。

【結果と考察】上記のモデルを用いて、ジフェ ニルヘキサトリエン結晶において観測された磁 場効果を解析した。実際に観測された蛍光の減 衰過程に対する磁場効果(時間分解測定)およ び蛍光強度に対する磁場効果(定常状態測定) をモデル計算により再現することができた。こ



Figure 1: Triplet pair model used in the present study [5].



Figure 2: Triplet hopping rate (k_h) dependences of magnetic field effects on fluorescence intensities at 5 T obtained by model calculations.

のことは、RP モデルが TP の MFE の解析に適用可能であることを示している。次に MFE の 大きさが SF のパラメータにどのように依存しているかを明らかにするため、様々なモデル計 算を行った。図2に蛍光強度に対する磁場効果(@5 T)の三重項励起子の拡散速度依存性を 示す。MFE の大きさは、ある拡散速度において最大となることがわかる。今回用いたパラメ ータセットにおいては、拡散速度が TF 速度の 1/10 程度の場合に MFE が最大となった。拡散 が遅すぎる場合や速すぎる場合には MFE の大きさは減少する。このように RP モデルの適用 により、TP に対する MFE の特性を明らかにすることができた。また、MFE データを解析す ることにより SF ダイナミクスのパラメータを決定することができる。MFE 測定が SF 研究に おいて非常に有用であることが示された。

[1] Smith, M.; Michl, J. Chem. Rev. 2010, 110, 6891-6936.

[2] Merrifield, R. E. Pure Appl. Chem. 1971, 27, 481-498.

[3] Rodgers, C. T. Pure Appl. Chem. 2009, 81, 19-43.

[4] Pedersen J. B.; Freed, J. H. J. Chem. Phys. 1971, 58, 2746-2762. and ibid, 1971, 59, 2869-2885.

[5] Wakasa, M.; Kaise, M.; Yago, T.; Katoh, R.; Wakikawa, Y.; Ikoma, T. J. Phys. Chem. C 2015, 119, 25840-25844.